

Kas ehitada Luunja sild? : lisand meie teede- ning liiklemispoliitika plaanikindlustamiseks

Vaher, G. ERK 1934 / lk. 133-138 : joon

Tuletikumonopol : "ratsionaliseerimise" tulemus ühes meie tööstusharus : [A.S. Eesti Tuletikumonopol]

Vaher, G. Akadeemia 1939 / lk. 131-136

Ultra-fast turn-on medium power thyristor

Vaher, G.; **Udal, Andres**; Typpö, J.; Paomets, V.; Sivonen, M. BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 567-572: ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Ultra-fast-turn-on medium power double thyristor

Vaher, G.; **Udal, Andres**; Sivonen, M.; Paomets, V. ESSDERC'95 : proceedings of the 25th European Solid State Device Research Conference, the Netherlands Congress Centre, the Hague, the Netherlands, 25th-27th September 1995 1995 / p. 647-650: ill

Высоковольтный диод серии В9

Vaher, G.; Vergi, U.; Karuks, O.; Kuusik, E.; Krunk, O.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 5-12 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; **Velme, Enn**; Lumi, J.; **Tarma, Mati**; **Udal, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17 : ил https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью

Vaher, G.; **Velme, Enn**; **Tarma, Mati** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12 : ил https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных электросварочных диодов

Vaher, G.; **Velme, Enn**; Mäe, T.; **Freidin, Boris** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15 : ил https://www.ester.ee/record=b1264428*est

К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых р-п переходах

Vaher, G.; **Velme, Enn** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Низковольтные диоды на большие токи с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Karuks, O.; Mäe, T.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 23-29 : ил https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Низковольтный диод для электросварки и гальваники с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 50-62 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

О возможности улучшения прямой ВАХ высоковольтного диода

Vaher, G.; Krunk, O.; Kuusik, E.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 13-20 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

О целесообразности увеличения обратного напряжения силовых кремниевых диодов

Vaher, G.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 21-24 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Определение характеристик силовых диодных структур методом фотохронографии рекомбинационного излучения

Kruusing, Arvi; **Udal, Andres**; Vaher, G. Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 129-133 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах

Vaher, G.; **Velme, Enn** Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Усовершенствование технологии и конструкции диодов Д143-2000 с применением диффузионной сварки

Vaher, G.; Karuks, O.; Kruus, J.; Surženkov, G.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Технология силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1987 / с. 134-138 : ил., табл https://www.ester.ee/record=b1353933*est